

**94-0147**

Invenția se referă la tehnologia semiconductoarelor și poate fi utilizată pentru obținerea straturilor subțiri InP pure cu parametri electrofizici reproductibili înalți.

Pentru reducerea nivelului de aliere necontrolabilă și a timpului de stabilire a regimului de creștere a straturilor cu parametri electrofizici reproductibili în cadrul procedurii de obținere a straturilor InP prin metoda epitaxiei în sistemul In-PCl<sub>3</sub>-H<sub>2</sub> se efectuează în prealabil tratarea termică a indiului în vid.

Rezultatul tehnic al invenției revendicate constă în reducerea nivelului de aliere necontrolabilă și a duratei de stabilire a regimului de creștere a straturilor subțiri cu parametri electrofizici reproductibili.